

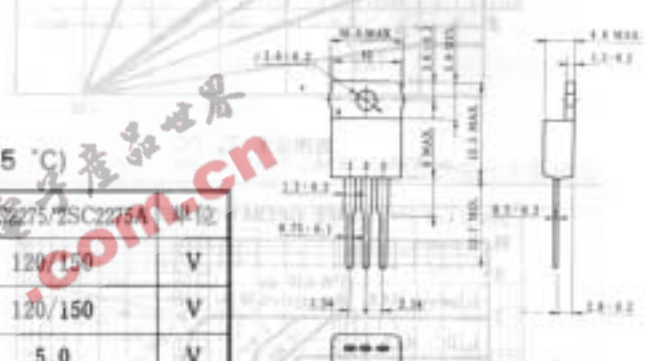
## 2SA985,985A/2SC2275,2275A

PNP/NPNエピタキシャル形  
シリコントランジスタ  
低周波電力増幅用, 高周波電力増幅用

PNP/NPN Silicon Epitaxial Transistor  
Audio Frequency Power Amplifier,  
High Frequency Power Amplifier

## 特長 / FEATURES

- 実効出力60~120 W用パワーアンプのドライバ段として最適。
- 高耐圧であり,かつ  $f_T$ が高い。
- $h_{FE}$ ,  $f_T$ の大電流の伸びが良い。

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS  
(Unit: mm)

- 電極接続  
1. Base  
2. Collector (Fin)  
3. Emitter  
4. Fin

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項目	略号	2SA985/2SA985A	2SC2275/2SC2275A	単位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-120/-150	120/150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	-120/-150	120/150	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-5.0	5.0	V
コレクタ電流(直流)	$I_{C(DC)}$	-1.5	1.5	A
コレクタ電流(パルス)	$I_{C(max)P}$	-3.0	3.0	A
ベース電流(直流)	$I_{B(DC)}$	-0.3	0.3	A
全損失	$P_T(T_c=25^\circ\text{C})$	25	25	W
全損失	$P_T(T_a=25^\circ\text{C})$	1.5	1.5	W
ジャンクション温度	$T_j$	150	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150	-55~+150	$^\circ\text{C}$

\*PW $\leq$ 10 ms, duty cycle $\leq$ 50 %

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

2SA985, 2SA985A/2SC2275, 2SC2275A

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -120/120\text{ V}$ , $I_E = 0$			-1.0/1.0	$\mu\text{A}$
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -3.0/3.0\text{ V}$ , $I_C = 0$			-1.0/1.0	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE} = -5.0/5.0\text{ V}$ , $I_C = -5.0/5.0\text{ mA}$ *	35	160/130		
直流電流増幅率	$h_{FE2}$	$V_{CE} = -5.0/5.0\text{ V}$ , $I_C = -0.3/0.3\text{ A}$ *	60	150	320	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -1.0/1.0\text{ A}$ , $I_B = -0.1/0.1\text{ A}$ *		-0.3/0.2	-2.0/2.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -1.0/1.0\text{ A}$ , $I_B = -0.1/0.1\text{ A}$ *		-0.9/0.9	-1.5/1.5	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = -5.0/5.0\text{ V}$ , $I_C = -0.2/0.2\text{ A}$		180/200		MHz
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10/10\text{ V}$ , $I_E = 0$ , $f = 1.0\text{ MHz}$		29/19		pF

\* Pulse Test/PW $\leq$ 350  $\mu\text{s}$ , duty cycle $\leq$ 2 %

$h_{FE}$ 区分( $h_{FE2}$ )/R: 60~120 Q: 100~200 P: 160~320